

研究简报

## 中子嬗变掺杂直拉硅的内吸除效应

张维连, 徐岳生, 李养贤

河北工学院 天津

收稿日期 1990-2-26 修回日期 1990-6-27 网络版发布日期 2009-10-16 接受日期

摘要

中子嬗变掺杂直拉硅的内吸除机理与直拉硅不同,它是辐照缺陷与硅中氧杂质相互作用的结果。在1100℃、热退火4h即可完成中子嬗变掺杂直拉硅的内吸除处理。

关键词 [直拉硅](#) [中子嬗变掺杂直拉硅](#) [内吸除效应](#)

分类号

## THE INTRINSIC GETTERING EFFECT OF NTDCZSI

Zhang Weilian, Xu Yuesheng, Li Yangxian

Hebei Institute of Technology Tianjin

Abstract

The mechanism of intrinsic gettering (IG) effect for Neutron Trans-mutation Doped Czochralski Silicon (NTDCZSI) differs from that of Czochralski Silicon (CZSi), and it results from the interaction between irradiation defects and interstitial oxygen. Annealing at 1100℃ for 4h, the intrinsic gettering of NTDCZSi can be performed.

Key words [Czochralski silicon \(CZSi\)](#) [Neutron transmutation doped CZSi \(NTDCZSi\)](#) [Intrinsic gettering effect \(IG\)](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 张维连; 徐岳生; 李养贤

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1039KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“直拉硅”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张维连](#)

· [徐岳生](#)

· [李养贤](#)